



近红外相位调制器

特性：

- 高功率处理： 100mW@1064nm
- 高稳定性
- 单驱动结构
- 高带宽（10GHz 以上）
- 低驱动电压，低插入损耗

应用：

- 脉冲发生，脉冲整形，脉冲拾取
- 激光雷达



主要规格

参数	相位调制器
光插入损耗	3.5dB (4 dB)
3 dB 带宽	4~5GHZ 10~12GHZ 0.1~0.15GHz
调制电压 Vpi (@ 50kHz)	6.0 volts 8.0 volts 2.5 volts
阻抗	50 Ω（RF） 10000 Ω（RF）
S11	-12 dB
光回波损耗	-50dB
晶体	Lithium Niobate x-cut,y-propagating
封装尺寸	100x 15x9.5(mm ³)
射频接口	Wiltron Female K type
波导形成方式	Proton exchange
工作波长区域	1060nm (850nm)
输入光纤	保偏
输出光纤	保偏
光学接口	FC/SPC standard (FC/APC & others available)
选项	输入输出光纤接头可选 带宽可适当增大或缩小

也可提供 40G 相位调制器。